











	<h2 style="color: red;">FQD2N60TM</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQD2N60TM</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 2A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQD2N60TM.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD2N60TM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 2A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 45W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.7 Ohm @ 1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)









FQD2N60TM ist neu im Original, Suche FQD2N60TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD2N60TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD2N60TM: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD2N60TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2A DPAK</p>	 <p><b>FQD2N80TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.8A DPAK</p>	 <p><b>FQD2N60TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2A DPAK</p>	 <p><b>FQD2N60TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2A DPAK</p>
 <p><b>FQD2N60CTM_WS</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.9A</p>	 <p><b>FQD2N60CTM-WS</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.9A</p>	 <p><b>FQD2N65C</b> VB FQD2N65C VB</p>	 <p><b>FQD2N80TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.8A DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

 FQD24N08TF	 FQD24N08TM	 FQD24N08TM	D FQD2N100	 FQD2N100TM
 FQD2N100TM	 FQD2N30TF	D FQD2N40TM	 FQD2N40TM	 FQD2N50B
 FQD2N50C	 FQD2N50TF	 FQD2N50TF	 FQD2N50TM	 FQD2N50TM
D FQD2N60A	 FQD2N60C	 FQD2N60CTF	 FQD2N60CTF	 FQD2N60CTF-NL
 FQD2N60CTF_F080	 FQD2N60CTF_F080	 FQD2N60CTM	 FQD2N60CTM	 FQD2N60TM
 FQD2N65C	 FQD2N80TM	D FQD2N80TM	 FQD2N80TM-NL	 FQD2N90TF
 FQD2N90TF	D FQD2P25TF	 FQD2P25TM	 FQD30N06	 FQD30N06L
 FQD30N06LTF	 FQD30N06LTF	 FQD30N06LTM	 FQD30N06LTM	 FQD30N06TF
 FQD30N06TF	 FQD30N06TF_F080	 FQD30N06TF_F080	D FQD30N06TM	 FQD30N06TM
 FQD30P06	 FQD3N25T	 FQD3N30TF	 FQD3N30TF	 FQD3N30TM

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited